

تحلیل اثرات حرارتی روى جريان الکترواسمتیک درون یک ریزمجرای تخت به روش لتیس بولتزمن

عامر علیزاده^۱، سید علی میربزرگی^{۲*}

۱- دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه بیرجند، بیرجند

۲- استادیار مهندسی مکانیک، دانشگاه بیرجند، بیرجند

* بیرجند، صندوق پستی ۹۷۱۷۵/۳۷۶ mirbozorgi@yahoo.com

چکیده- در این مقاله اثر دمای سیال ورودی روی طرح جریان الکترواسمتیک درون یک ریزمجرای تخت با دیوارهای دما ثابت توسط حل معادلات حاکم به روش لتیس بولتزمن تحلیل شده است. هدف اصلی این مطالعه جستجوی اثرات تغییر دما بر توزیع یون‌ها و به تبع آن، پتانسیل الکتریکی داخلی و میدان سرعت سیال می‌باشد. برای آنکه بتوان از معادله توزیع یون بولتزمن استفاده کرد از دمای میانگین کاسه‌ای برای هر مقطع از ریزمجرای استفاده شده است. در روش لتیس بولتزمن بکار رفته، از مدل ال.بی.جی. کی برای مدلسازیتابع برخورد معادله بولتزمن و از شرایط مرزی زو-هی برای میدان سرعت استفاده شده است. از مدل وانگ برای حل معادله پواسون-بولتزمن و از مدل هی-چن برای حل معادله اనرژی استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهند که با افزایش اختلاف دمای سیال ورودی و دمای دیوارها میزان دبی جریان الکترواسمتیک افزایش می‌یابد. همچنان مشاهده شد که با کاهش پتانسیل الکتریکی خارجی، افزایش اختلاف دما و کاهش ضخامت لایه دو گانه الکتریکی، در ناحیه وروردی ریزمجرای، منطقه‌ای با جریان بازگشتی تشکیل می‌شود که می‌تواند به منظور کنترل طرح جریان داخلی موثر واقع شود.

کلیدواژگان: جریان الکترواسمتیک، ریزمجرای تخت، اثرات دما، روش لتیس بولتزمن، دمای میانگین کاسه‌ای.

The analysis of thermal effects on the electro-osmotic flow in a microchannel with the Lattice Boltzmann method

A. Alizadeh¹, S.A. Mirbozorgi^{2*}

1- MSc of Mech. Eng., Birjand Univ., Birjand, Iran

2- Assist. Prof. of Mech. Eng., Birjand Univ., Birjand, Iran

* P.O.B. 97175/376 Birjand, Iran. Mirbozorgi@yahoo.com

Abstract- In this paper the effects of the inlet fluid temperature on the electro-osmotic flow pattern in a two-dimensional microchannel with constant walls temperature is investigated with solving the governing equations by the Lattice Boltzmann method. The main objective of this research is to study the effects of temperature variations on the distribution of ions and consequently internal electric potential and velocity field. For make possible to use the Boltzmann ion distribution equation, cup mean temperature for every cross section of the microchannel is used. At the used Lattice Boltzmann method, *LBGK* model for modeling the Boltzmann collision function and the Zou-He boundary conditions method for velocity field has been used. Wang model for solving the Poisson-Boltzmann and He-Chen model for solving the energy equation has been used. The results show that, with increase the temperature difference between the inlet flow and the walls, the electro-osmotic flow rate increases. Also, observed that with decrease the external electric potential and the electric double layer thickness and increase the temperature difference at the inlet zone of the microchannel, a region with return flow is formed which can be used for controlling the internal flow pattern.

Keywords: Electro-Osmotic Flow, Microchannel, Temperature Effects, Lattice Boltzmann Method, Cup mean Temperature.

می‌توان نشان داد که وقتی دمای الکتروولیت یکنواخت باشد سرعت بیشینه (در ناحیه تخت) یا همان سرعت مرتع در جریان الکترواسمتیک از رابطه زیر که به سرعت هلمهولتز- اسمولوکفسکی^۵ معروف است، به دست می‌آید:

$$U_{ref} = -\frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r E_x \zeta}{\mu}$$

در این رابطه (V)^۶ پتانسیل الکتریکی دیوارهای و منفی، (E_x V/m) قدرت میدان الکتریکی خارجی، (c/Vm)^۷ ضریب گذردهی الکتریکی خلا، ζ نسبت ضریب گذردهی الکتریکی الکتروولیت به مقدار نظیرش در خلا و (Pas)^۸ لزجت دینامیکی سیال می‌باشد. از مزایای کاربردی یک جریان الکترواسمتیک، کنترل پذیری آن توسط میدان الکتریکی خارجی است. لذا به عنوان مثال جداسازی گونه‌های معلق در چنین جریان‌هایی به آسانی امکان پذیر می‌شود، چرا که سرعت برشی و یا به عبارتی عامل مؤثر در جداسازی گونه‌ها با تغییر میدان الکتریکی خارجی به سهولت ایجاد می‌شود [۳]. از طرف دیگر این جریان می‌تواند به آسانی با تغییر جهت میدان الکتریکی به صورت زمانی و یا مکانی نوسان کند و لذا در فرایندهای مخلوط سازی مناسب باشد [۴]. بدینهی است چنانچه پارامترهای موثر در جریان الکترواسمتیک را بتوان به طور هدفمند تغییر داد آنگاه می‌توان پروفیلهای سرعت متفاوت و قابل کنترلی را ایجاد نمود. به عنوان مثال میربزرگی و همکاران [۵] به طور عددی نشان دادند که توزیع غیریکنواخت زتا پتانسیل بر روی دیوارهای یک ریز مجرما می‌تواند پروفیل‌های سرعت غیر پلاگ^۹ ایجاد نماید. هیر و همکاران [۶] در یک کار تجربی ایده تولید پروفیلهای سرعت غیر پلاگ را توسط ساختن ریز مجرایی که مقدار زتا پتانسیل بر روی سطوح آن می‌توانست متغیر باشد تأیید نمودند. شاسفتر و همکاران [۷] روش متفاوتی را برای کنترل میدان سرعت ارائه نمودند. آنها با تغییر میدان الکتریکی خارجی، حتی مقدار زتا پتانسیل بر روی دیوارهای را نیز تغییر داده و لذا جریان را شتاب‌گیر، کندشونده و یا برگشتی نمودند.

یکی از پارامترهای فرعی اما مهم در امر کنترل جریان الکترواسمتیک می‌تواند دما باشد. این کنترل پذیری از ناحیه وابستگی خواص فیزیکی به دما و نیز اثر مستقیم دما بر توزیع

۱- مقدمه

ایجاد حرکت در سیال درون یک ریز مجرما، مانند آنچه در ریز آزمایشگاه‌ها^۱ وجود دارد، چالشی مورد توجه و علاقه جهت بررسی می‌باشد. ایجاد حرکت توسط میکروپمپ‌های مکانیکی مستلزم داشتن بخشی محرک است که باعث دشواری تولید و همچنین آببندی و کنترل این نوع میکروپمپ‌ها خواهد شد. از طرف دیگر، در یکی از روش‌های نسبتاً جدید، سیال به واسطه حرکت یون‌های محلول در خودش به حرکت در می‌آید [۱]. کارایی این روش غیر مکانیکی بیوژه در به حرکت درآوردن سیالاتی با لزجت بالا، عامل مهمی است که بررسی و مطالعه چنین جریان‌هایی را توجیه پذیر کرده است [۲]. پمپ‌های فوق با توجه به عدم نیاز به بخش مکانیکی، می‌توانند به سهولت سیال را درون یک ریز مجرما توسط اعمال یک میدان الکتریکی خارجی انتقال دهند. از این رو کنترل پذیری این پمپ‌ها بسیار آسان‌تر می‌باشد. از آنجا که سطح مشترک هر جامد- مایعی می‌تواند دارای بارهای الکترواستاتیکی باشد، یک لایه نسبتاً نازک (در حد ۱۰۰ نانومتر) از یون‌های مخالف (نسبت به بار الکتریکی روی سطح جامد) در مجاورت سطح و در بخش مایع ایجاد می‌شود. به مجموعه این لایه و لایه مربوط به بارهای روی سطح جامد، لایه دوگانه الکتریکی^{۱۰} (EDL) می‌گویند. حضور لایه دوگانه الکتریکی در مجاورت دیوارهای یک ریز مجرما اغلب می‌تواند روی انتقال الکتروولیتها درون آنها منشاء اثر و دارای اهمیت کاربردی باشد. به عنوان مثال اگر یون‌های موجود در این لایه به واسطه نیروی حاصل از اعمال یک میدان الکتریکی خارجی به موازات دیوارهای ریز مجرما شروع به حرکت کنند لزجت سیال باعث می‌شود تا بقیه مولکولهای سیال نیز همراه این یون‌ها به حرکت در آیند. به چنین جریانی، جریان الکترواسمتیک^{۱۱} (EOF) گفته شده و پروفیل سرعت آن برای لایه‌های دوگانه الکتریکی کوچک (نسبت به عرض ریز مجرما) دوشاخه مانند^{۱۲} است. به عبارت دیگر بخش اعظم (میانی) پروفیل سرعت در ناحیه خارج از لایه دوگانه الکتریکی تخت است ($0 = \frac{\partial u}{\partial y}$) و به تبع آن اصطکاک بین لایه‌های آن صفر می‌باشد.

1. Lab-On-a-Chip
2. Electric Double Layer
- 3 Electro- Osmotic Flow
4. Plug Like Flow

5. Helmholtz-Smoluchowski
6. Non- Plug like flow

لتیس بولتزمن، جریان الکترواسمتیک درون یک ریزمجرای تخت را مدل کردند. چیزی و شی [۱۲] با حل معادله مومنتوم توسط مدل تراکم ناپذیر لتیس بولتزمن و ارائه مدلی جدید جهت حل معادله پواسون-بولتزمن توسط روش لتیس بولتزمن، جریان الکترواسمتیک درون یک ریزمجرای تخت را تجزیه و تحلیل کردند.

یانگ شی و همکاران [۱۳] برای لایه دوگانه الکتریکی بسیار کوچک ($K = Kh = (h/\lambda) > 200$)، مدلی ساده شده را ارائه دادند که در آن با استفاده از آنالیز ابعادی مقدار دما و سرعت را در مرز بین این لایه و سیال محاسبه کرده‌اند. آنها سپس با حذف تمامی جملات مربوط به این لایه در معادلات مومنتوم و انرژی، مقادیر سرعت و دمای بهدست آمده از آنالیز ابعادی را به عنوان شرایط مرزی برای مابقی جریان درنظر گرفتند. همچنین برای حل معادلات مومنتوم و انرژی از روش لتیس بولتزمن برای جریان‌های ساده به همراه انتقال حرارت استفاده کردند. آنها نشان دادند که این روش برای لایه‌های دوگانه الکتریکی دارای ضخامت بسیار کوچک کارآیی خوبی دارد. تمامی موارد بالا نشان می‌دهند که تلاش برای کنترل و مطالعه پروفیل سرعت و به تبع آن جریان الکترواسمتیک از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هدف اصلی مطرح در مقاله حاضر، بررسی اثر تغییر دما بر توزیع یون‌ها در راستای طولی است چرا که انتظار می‌رود اثرات حاصل از آن بر میدان سرعت و پتانسیل الکتریکی داخلی قابل توجه باشد. اگرچه این بررسی می‌باشد در عرض ریزمجرای نیز مورد توجه قرار گیرد اما بدليل پرهیز از پیچیدگی بیشتر در کار حاضر، فقط اثر تغییر دما بر توزیع یون‌ها در طول ریزمجرای مطالعه قرار گرفته است. بررسی کارهای منتشر شده که بعضًا ذکر شد نشان می‌دهد تمرکز مطالعات اغلب روی تغییر خواص فیزیکی الکتروولیت با دما و تأثیر متقابل آن بر جریان الکترواسمتیک معطوف بوده است [۱۰-۸]؛ حال آنکه انتظار می‌رود تغییرات دما روی توزیع یون‌های مثبت و منفی و سایر پارامترهای دینامیکی جریان اثر قابل ملاحظه‌ای داشته باشد.

در مطالعه حاضر بجای حل معادله انتقال یون (ارنس-پلانک)، معادله بولتزمن حاکم بر توزیع یون‌ها با فرض دمای کاسه‌ای مخلوط^۳ برای هر یک از مقاطع عرضی در طول ریزمجرای حل شده است. با این فرض خاص توزیع عرضی یون‌ها

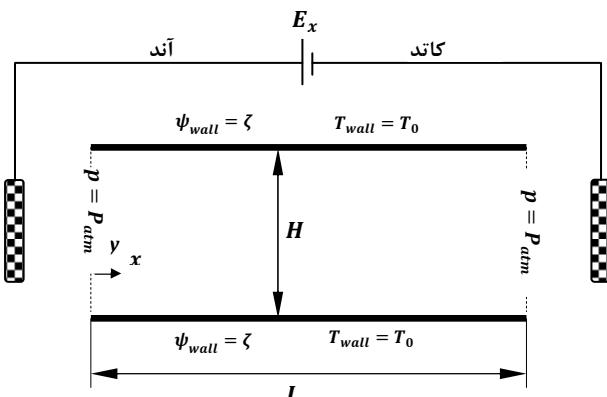
یون‌ها صورت می‌گیرد. مطالعه بر روی انتقال حرارت جابه‌جا‌ی در ریزمجراهای با نگرش افزایش انتقال حرارت و حل میدان دما در یک دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است. اما این مطالعات تنها از منظر خود دما مورد بررسی قرار گرفته‌اند. به‌طور مثال مala و همکاران [۸] یک تحقیق ساختاری و پایه‌ای را بر روی توزیع دما درون یک ریزمجرای تخت انجام دادند. در تحقیق آنها معادله پواسون-بولتزمن (با اعمال تقریب دبای-هوکل) و معادلات مومنتوم به صورت تحلیلی حل شده‌اند، حال آنکه معادله ارزی با استفاده از روش‌های عددی حل شده و از اثر میدان دمایی بر توزیع یون‌ها صرف‌نظر شده است. آنها نشان دادند که با کاهش ضخامت لایه دوگانه الکتریکی میزان انتقال حرارت افزایش خواهد یافت.

هو سانگ کواک و همکاران [۹] نیز تأثیر میدان دمایی را بر جریان الکترواسمتیک مورد بررسی قرار داده‌اند. آنها تمامی معادلات را به صورت عددی و با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی مرسوم حل کرده‌اند. در کار آنها جریان الکترواسمتیک درون یک ریزمجرای تخت با دمای متغیر روی دیوارهای مطالعه قرار گرفته است و تأثیر میدان دما بر میدان جریان سیال نیز به واسطه در نظر گرفتن خواص فیزیکی متغیر با دما میسر شده است. هدف اولیه آنها کنترل سرعت جریان به واسطه تغییرات میدان دما بوده است. نتایج آنها نشان می‌دهد که چنانچه در راستای عمودی بین دو صفحه موازی، تغییر دما وجود داشته و یا به عبارت ساده‌تر دمای صفحات بالا و پایین با یکدیگر متفاوت باشند، جریانی شبیه جریان کوئت^۱ ایجاد خواهد شد. همچنین اگر دمای صفحات در راستای طول مجرای بصورت مکانی تغییر نمایند الگویی از جریان‌های گردابه‌ای ایجاد خواهد شد. مطالعه لیانو و همکاران [۱۰] بیشتر بر یافتن مقدار بهینه عدد بی بعد K برای بهبود پمپ کردن سیال توسط جریان الکترواسمتیک معطوف بوده و همچنین اثرات گرمایشی ژول نیز بر پمپ کردن سیال مورد بررسی قرار داده‌اند.

اخیراً مطالعات چندی بهمنظور مدل‌سازی جریان الکترواسمتیک و همچنین در مواردی با ارائه مدل لتیس بولتزمن جدیدی جهت حل معادله پواسون-بولتزمن و یافتن توزیع پتانسیل الکتریکی، ارائه شده است. تانگ و همکاران [۱۱]، با حل معادلات مومنتوم و پواسون-بولتزمن توسط روش

2. Mixing Cup Temperature

بقدرتی از ورودی و خروجی کانال دور انتخاب می‌شود که اثر جانبی افت‌های ورودی و خروجی مجرای قابل اغماض باشد.



شکل ۱ طرحواره یک ریزمجرای دو بعدی تخت با دما و پتانسیل الکتریکی ثابت بر روی دیوارهایها

در مطالعه حاضر، فرض شده است که ریزمجرای تخت از جنس سیلیکون بوده و الکتروولیت با یون‌های K^+ و CL^- بعنوان سیال انتخاب شده‌اند. بعلاوه فرض شده است زتا پتانسیل در سطح مشترک سیال با دیواره منفی بوده و می‌تواند در دامنه $-25 \text{ mV} \leq \zeta \leq -100 \text{ mV}$ مقدار داشته باشد. با توجه به تعریف پارامتر بی بعد $c = KH = H/\lambda$ ، که در آن عرض کانال H با ضخامت مشخصه لایه دوگانه الکتریکی یعنی:

$$K^{-1} = \lambda = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r K_B T_0}{2 Z^2 e^2 n_0}}$$

بی بعد شده است، در اینجا با انتخاب مقدار κ و H مقدار n_0 تعیین می‌شود. بعضًا به جای غلظت عددی یون‌ها، n_0 مقدار غلظت مولار، c ، نیز تعیین می‌شود.

در این صورت غلظت مولار برحسب kmol/m^3 و به صورت $(c = n_0/(1000 N_A))$ محاسبه می‌شود که در آن N_A عدد آوگادرو است.

جدول ۱، تعاریف اعداد بی بعد ترموهیدرودینامیکی حاکم بر جریان الکترواسمتیک را نشان می‌دهد. با توجه به اینکه متغیرهای ζ ، μ ، k ، ε_0 ، ε_r می‌توانند با دما تغییر کنند، لذا با توجه به ثابت در نظر گرفتن آنها در این مطالعه از مقادیرشان در $T = 293\text{K}$ به عنوان مرجع در تعاریف اعداد بی بعد فوق استفاده خواهد شد. سایر کمیات فیزیکی نظریه ریزمه را همواره ثابت هستند و مقادیرشان مطابق جدول ۲ ارائه شده است.

به‌طور محلی به کمک معادله نمایی توزیع بولتزمن تعیین می‌شوند حال آنکه امکان تغییر توزیع یون‌ها در راستای جریان بدليل تغییرات طولی دما همچنان وجود دارد. از آنجا که در حالت کلی هنگامی می‌توان از معادله نمایی توزیع بولتزمن برای یون‌ها استفاده نمود که جریان الکترواسمتیک کاملاً توسعه یافته باشد، لذا در این مطالعه با توجه به تغییر دما و عدم توسعه یافتنی یونی، استفاده از توزیع نمایی بولتزمن در راستای طولی می‌تواند بعنوان یک فرض ساده کننده در نظر گرفته شود. با توجه به اینکه سه معادله پواسون-بولتزمن، مومنتوم و انرژی از طریق دما با یکدیگر کوپل می‌باشند بنابراین حل تؤام این سه معادله به‌طور تکراری انجام شده است.

روش عددی بکار رفته در اینجا، روش لتیس بولتزمن می‌باشد. از مدل وانگ [۱۴] جهت حل معادله پواسون-بولتزمن و از مدل لتیس بولتزمن بی جی کی جهت حل معادله مومنتوم استفاده شده است [۱۵]. در نهایت معادله انرژی با استفاده از مدل هی-چن [۱۶] حل می‌شود.

برای اعتبار سنجی نتایج حاصل از بکارگیری روش لتیس بولتزمن، حل عددی به دست آمده با حل تحلیلی موجود در شرایط خاص مقایسه شده و درستی عملکرد کد عددی برای توزیع سرعت و پتانسیل الکتریکی داخلی نشان داده شده است. همچنین مسئله انتقال حرارت جابه‌جایی درون یک کانال حل شده و مقادیر ناسلت و دمای میانگین محلی حاصل از حل عددی با نتایج حل تحلیلی موجود مقایسه شده‌اند.

۲- تعریف مسئله

مطابق شکل ۱، جریان الکترواسمتیک مورد مطالعه در این مقاله حاصل از عبور یک الکتروولیت متقارن درون ریزمجرای دو بعدی تخت بطول L و عرض H است که صفحات بالا و پایین آن دمای T_{wall} و پتانسیل الکتریکی ζ را اخذ نموده‌اند. عامل حرکت سیال نیز میدان پتانسیل الکتریکی خارجی با قدرت E_x است که توسط دو الکترود آند و کاتد واقع در دو سر ریزمجرای اعمال شده است.

نسبت طول به عرض این ریزمجرای (L/H) برابر ۵ می‌باشد. الکتروولیت متقارن در اینجا دارای نسبت یونی ۱:۱ است (یعنی مقادیر عدد والانس یون‌ها برابر می‌باشند، $|Z_+| = |Z_-| = Z = 1$). محل استقرار صفحات آند و کاتد

همانطور که در بالا بیان شد در جریان الکترواسمتیک بین دو صفحه موازی سرعت مرجع جریان می‌تواند با رابطه زیر

معرفی شود:

$$U_{ref} = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r E_x \zeta}{\mu}$$

ملاحظه می‌شود که برای مقادیر ثابت E_x و ε_0 سه پارامتر $\zeta, \mu, \varepsilon_r$ می‌توانند با دما تغییر کنند.

کواک و همکاران [۹] نشان دادند که برای بازه دمایی $\varepsilon_r(T) < T < 323.15(K)$ حاصلضرب $(K_B T_0 / Ze) \times \zeta(T)$ تقریباً برابر ۱ خواهد شد؛ در نتیجه می‌توان گفت که سرعت مرجع در این بازه دمایی فقط می‌تواند با دما و به واسطه ویسکوزیته به صورت $1/\mu(T)$ تغییر کند. در مطالعه حاضر تنها به منظور بررسی اثرات تغییر دما بر توزیع یون‌ها و به تبع آن جریان الکترواسمتیک، از تغییرات ویسکوزیته با دما صرف‌نظر خواهد شد. به علاوه چنانچه میزان ولتاژ اعمالی خارجی کوچک باشد، می‌توان از اثرات گرمایی ژول (ناشی از مقاومت الکتریکی سیال در برابر عبور بار الکتریکی) بر جریان الکترواسمتیک صرف‌نظر کرد. به دلیل پایین بودن نرخ کرنش سیال در محدوده وسیعی از عرض ریز‌ مجرفا از اتفاقات لزجی نیز صرف‌نظر شده است.

۳- فرمولاسیون محیط پیوسته مسئله

۱-۳- معادله پواسون-بولتزمن

بر پایه تئوری الکترواستاتیک [۱۷]، معادله حاکم بر توزیع پتانسیل الکتریکی، $\nabla^2 \psi = 0$ می‌تواند به وسیله یک معادله پواسون و به صورت زیر تعریف شود:

$$\frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{\partial \psi}{\partial x} \right] + \frac{\partial}{\partial y} \left[\frac{\partial \psi}{\partial y} \right] = -\frac{\rho_e(x, y)}{\varepsilon_r \varepsilon_0} \quad (1)$$

که در آن ρ_e چگالی خالص بار خالص الکتریکی محلی، $\psi(x, y)$ پتانسیل الکتریکی در فضای دوبعدی، ε_0 ضریب گذردهی الکتریکی خلا و ε_r نسبت ضریب گذردهی الکتریکی الکتروولیت به نظریش در خلا می‌باشد. چگالی خالص بار الکتریکی ρ_e می‌تواند به صورت زیر تعریف شود:

$$\rho_e = Ze(n^+ - n^-) \quad (2)$$

که در آن n^+ و n^- غلظت عددی یون‌های مثبت و منفی با دیمانسیون $Z \text{ ion/m}^3$ عدد والنس یون‌ها و e مقدار بار الکتریکی یک الکترون است با دیمانسیون C طبق تئوری

جدول ۱ پارامترهای بی‌بعد و تعاریف آنها

پارامترهای بی‌بعد	تعریف رابطه پایه
Pr	$\frac{v_{ref}}{\alpha_{ref}}$
Re	$\frac{U_{ref} H_{ref}}{v_{ref}}$
A	$\frac{E_{ref} H_{ref}}{K_B T_0 / Ze}$
B	$\frac{n_0 K_B T_0}{\rho_{ref} U_{ref}^2}$
κ	$\sqrt{\frac{2 Z^2 e^2 n_0}{\varepsilon_0 \varepsilon_r K_B T_0}} H_{ref}$

جدول ۲ ثوابت و مقادیر ترموفیزیکی

متغیر	مقدار (واحد)
H	$6 \times 10^{-9} (\text{m})$
e	$1/602 \times 10^{-19} (\text{c})$
K_B	$1/381 \times 10^{-23} (\text{J/K})$
n_{i_∞}	$6.022 \times 10^{23} (\text{ion/m}^3)$
ε_r	80
ε_0	$8.854 \times 10^{-12} (\text{c/vm})$
ρ	$1000 (\text{kg/m}^3)$
μ	$1 \times 10^{-7} (\text{Pa s})$
T_0	$323/15 (\text{K})$
c_p	$4180 (\text{J/kg K})$
k	$0.613 (\text{W/m K})$

مقدار T_0 حسب مورد تعیین خواهد شد. از جمله پارامترهای مهم جریان لزج درون یک ریز مجر، عدد رینولدز است که در مطالعه حاضر به عنوان ورودی مسئله انتخاب خواهد شد. به این ترتیب با معلوم بودن H, Re می‌توان U_{ref} به صورت زیر تعیین نمود:

$$U_{ref} = \frac{Re v}{H}$$

در ادامه با معلوم بودن زتا پتانسیل، می‌توان مقدار E_x

لازم جهت ایجاد جریانی با سرعت U_{ref} از رابطه:

$$E_x = \frac{-\mu U_{ref}}{\varepsilon_0 \varepsilon_r \zeta}$$

به دست آورد. به طور خالصه در هر مورد از حالات مطالعه،

مقادیر ζ, H, Re, K, C به عنوان ورودی مسئله تعیین می‌شوند و

در نتیجه مقادیر E_x, K, C به دست می‌آیند.

که $e(C)$ بار مطلق الکترون، $T_{mean}(K)$ دمای کاسه‌ای میانگین سیال در هر مقطع است. با استفاده از مراجع مناسب شکل بی‌بعد این معادله به صورت رابطه (۷) است:

$$\bar{\psi} = \frac{\psi}{\frac{K_B T_0}{Z_e}}, \bar{\rho}_e = \frac{\rho_e}{Zen_{i\infty}}, \bar{x} = \frac{x}{H}, \bar{y} = \frac{y}{H}$$

$$\frac{\partial^2 \bar{\psi}}{\partial \bar{x}^2} + \frac{\partial^2 \bar{\psi}}{\partial \bar{y}^2} = -\frac{\kappa^2 \bar{\rho}_e}{2} \quad (7)$$

شرایط مرزی حاکم بر معادله فوق به صورت زیر تعریف می‌شوند:

$$y = 0 \rightarrow \psi = \zeta, y = H \rightarrow \psi = \zeta$$

$$x = 0 \rightarrow \psi = 0, x = l \rightarrow \frac{\partial \psi}{\partial x} = 0 \quad (8)$$

۲-۳- معادلات اصلاح شده ناویر- استوکس

در اینجا معادلات اصلاح شده ناویر- استوکس بر اساس درج نیروی حجمی ناشی از اعمال میدان الکتریکی خارجی روی چگالی بار خالص موجود در لایه دوگانه الکتریکی کنار دیواره‌ها نوشته می‌شوند. بنابراین معادلات ناویر- استوکس اصلاح شده که شامل معادلات پیوستگی و مomentum می‌باشند، برای جریان تراکم‌ناپذیر الکتروولیتی در حالات لایه‌ای و پایا به صورت زیر بیان می‌شوند [۵]:

$$\nabla \cdot u = 0 \quad (9\text{-الف})$$

$\rho(u \cdot \nabla u) = -\nabla p + \mu \nabla^2 u - \rho_e(E + \nabla \psi) \quad (9\text{-ب})$

که در آن u بردار سرعت بر حسب $\frac{m}{s}$ (Pas)، μ لزجت دینامیکی الکتروولیت (در اینجا مستقل از دما)، $E(V/m)$ بردار قدرت میدان الکتریکی خارجی، $(kg/m^3)\rho$ چگالی جرمی الکتروولیت (در اینجا ثابت و مستقل از دما) و $p(pa)$ فشار هیدرودینامیکی سیال می‌باشد. جمله آخر سمت راست (۹-ب)، بیانگر نیروی حجمی الکتریکی است که به سیال وارد شده و عامل حرکت آن می‌باشد. از این پس نیروی حجمی در جهت x در این مقاله به صورت $(E_x - \frac{\partial \psi}{\partial x})BF = \rho_e$ نشان داده می‌شود. قابل ذکر است که در این مطالعه، هیچ‌گونه گرادیان فشاری در راستای جریان بر سیال اعمال نخواهد شد. در معادله (۹-ب) جمله مربوط به نیروی حجمی در جهت y ، به دو دلیل $E_y = 0$ و غلظت پایین یون‌های محلول در سیال، حذف شده است [۱۸]. بعبارت دیگر نیروی الکتریکی ناشی از گرادیان ψ در جهت y با نیروی ناشی از پخش یون‌ها پیش از این موازن شده‌اند و نهایتاً توزیع یون بولتزمن را نتیجه داده‌اند. موازن این دو نیرو فقط در مورد یون‌ها صادق بوده و به دلیل کم بودن

الکترواستاتیک غلظت عددی یون‌ها نیز خود وابسته به توزیع پتانسیل الکتریکی ψ می‌باشند و به عبارت ساده‌تر از توازن دو نیروی ناشی از پخش یون‌ها و گرادیان پتانسیل الکتریکی است.

برای مثال در حالت یک بعدی می‌توان داشت:

$$K_B T \left(\frac{dn^\pm}{dy} \right) = \mp Zen^\pm \left(\frac{d\psi}{dy} \right) \quad (3)$$

که در این معادله، سمت چپ معرف نیروی ناشی از پخش یونی و سمت راست ناشی از گرادیان پتانسیل الکتریکی است. n^\pm معرف غلظت عددی یون‌های مثبت و منفی است. انتگرال‌گیری از معادله (۳) به رابطه زیر می‌رسد:

$$n^\pm = n_{i\infty} e^{\mp \frac{Zen(x,y)}{K_B T_{mean}(x)}} \quad (4)$$

که در آن $n_{i\infty}$ غلظت عددی یون‌ها در حالت ۰ $= \psi$ است. رابطه به دست آمده به توزیع نمایی بولتزمن مشهور است و علاوه بر روش بیان شده می‌توان به کمک مقاهم ترمودینامیک آماری نیز آن را اثبات کرد. در این رابطه علامت (-) سمت راست برای تعیین توزیع غلظت یون‌های مثبت و علامت (+) برای تعیین توزیع غلظت یون‌های منفی بکار می‌رود. در این رابطه T دمای مطلق و بر حسب کلوین K ، K_B ثابت بولتزمن و بر حسب J/K است.

دو نکته مهم وجود دارد: اول اینکه معادله ارنست- پلانک معادله اصلی حاکم بر توزیع یون‌ها می‌باشد و دوم اینکه چنانچه در به دست آوردن معادله توزیع یون بولتزمن از معادله ارنست- پلانک، T در راستای y ثابت نباشد، نمی‌توان از رابطه (۳) انتگرال گرفت و به توزیع یون بولتزمن رسید. چنانچه نتوان از رابطه ارنست- پلانک به توزیع یون بولتزمن رسید، در نتیجه نمی‌توان از توزیع یون بولتزمن برای یافتن یون‌ها در فاصله y عمود بر صفحه استفاده کرد. پس اینجا علت در نظر گرفتن $T_{mean}(x)$ در این مطالعه مشخص می‌شود.

پیش از خاتمه بحث اکنون می‌توان با ترکیب معادلات (۲) و (۴) [۱۴]، معادله حاکم بر چگالی خالص بار الکتریکی که به معادله پواسون- بولتزمن مشهور است را به صورت زیر به دست آورده:

$$\rho_e(x, y) = -2Zen_{i\infty} \sinh \left(\frac{Zen(x, y)}{K_B T_{mean}(x)} \right) \quad (5)$$

معادله پواسون- بولتزمن نیز از ترکیب روابط (۲) و (۵) حاصل می‌شود:

$$\nabla^2 \psi = \frac{2Zen_{i\infty}}{\epsilon_0 \epsilon_r} \sinh \left(\frac{Zen(x, y)}{K_B T_{mean}(x)} \right) \quad (6)$$

در تمامی معادلات بی بعد شده، عدد رینولدز و پرانتل مطابق با جدول ۱ تعریف شده که در آنها $\alpha(m^2/s)$ ضریب نفوذ حرارتی، $v(m^2/s)$ ویسکوزیته سینماتیکی سیال می باشد. شرایط مرزی حاکم بر معادله انرژی به صورت رابطه (۱۴) می باشد:

$$\begin{aligned} y = 0 \rightarrow T = T_0, y = H \rightarrow T = T_0 \\ x = 0 \rightarrow T = T_{in}, x = l \rightarrow \frac{\partial T}{\partial x} = 0 \end{aligned} \quad (14)$$

لازم به ذکر است که به منظور عدم استفاده از نمادهای بیشتر، از این پس مقادیر بی بعد بدون علامت (-) نشان داده خواهند شد.

۴- فرمولاسیون مدل لتیس بولتزمن مسئله

در این مقاله، سه معادله حاکم بر پدیده مورد مطالعه (مومنتوم، پواسون-بولتزمن و انرژی) به صورت عددی و با استفاده از روش لتیس بولتزمن حل خواهند شد. لذا لازم است که معادلات هم ارز برای استفاده در روش لتیس بولتزمن معرفی شوند.

-۱-۴- مدل لتیس بولتزمن جهت حل معادله پواسون-بولتزمن (مدل وانگ)

چنانچه سمت راست معادله (۶) به صورت:

$$g_{rhs}(x, y) = -\frac{2Zen_0}{\varepsilon_0 \varepsilon_r} \sinh\left(\frac{Zen(x, y)}{K_B T_{mean}(x)}\right)$$

تعريف شود می توان معادله انتقال بولتزمن جهت حل معادله پواسون-بولتزمن را در دو بعد با توجه به مدل وانگ به صورت زیر نوشت:

$$g_i(X + e_t \delta_{t,g}, t + \delta_{t,g}) - g_i(X, t) = -\frac{1}{\tau_g} [g_i(X, t) - g_i^{eq}(X, t)] + \left(1 - \frac{0.5}{\tau_g}\right) \delta_{t,g} \omega_i g_{rhs} \quad (15)$$

که در آن $i = 0 - 8$ جهات نه گانه در شبکه D2Q9، X بردار مکان، e_i بردارهای g_i تابع توزیع پتانسیل الکتریکی، τ_g سرعت میکروسکوپیک ذرات در جهات نه گانه، ω_i سرعت زمانی و در اینجا برابر 1 ، $\delta_{t,g}$ ضریب بی بعد تخفیف زمانی که به صورت $\delta_{t,g} = \frac{3\chi\delta_{t,g}}{2\delta_x^2} + 0.5$ تعریف شده که در آن χ ثابت شبکه و δ_x ضریب پخش پتانسیل الکتریکی بوده که همواره برابر 1 در نظر گرفته می شوند. g_i^{eq} تابع توزیع تعادل ماکسول-بولتزمن برای پتانسیل الکتریکی و ω_i ضرایب وزنی

غلظت یونها در الکتروولیت تعداد مولکولهای سیال کمتری تحت تاثیر حرکت یونها قرار خواهد گرفت. در مورد مشابه برای معادله (۹-ب)، $\frac{\partial \psi}{\partial x}$ منشا بیرونی داشته و لذا با E_x جمع زده شده است. لازم به یادآوری است که نیروی ناشی از $\frac{\partial \psi}{\partial x}$ هیچ نیروی دیگری موازن نشده است، برخلاف نیروی حاصل از $\frac{\partial \psi}{\partial y}$ که با نیروهای حاصل از پخش یونی موازن شده است. به کمک عوامل بی بعد زیر معادله ممتومن به صورت معادله (۱۰) بی بعد می شود:

$$\bar{u} = \frac{u}{U_{ref}}, \bar{v} = \frac{v}{U_{ref}}, \bar{p} = \frac{P}{\rho U_{ref}^2}, A = \frac{E_{ref} H}{K_B T_0}, B = \frac{n_{i\infty} K_B T_0}{\rho U_{ref}^2}$$

$$(\bar{u} \cdot \nabla \bar{u}) = -\nabla \bar{p} + \frac{1}{Re} \nabla^2 \bar{u} + \bar{\rho}_e B (A \bar{E} - \nabla \bar{\psi}) \quad (10)$$

شرایط مرزی حاکم بر معادلات ناویر-استوکس به صورت زیر می باشد:

$$\begin{aligned} y = 0 \rightarrow u = v = 0, & \quad y = H \rightarrow u = v = 0 \\ x = 0 \rightarrow \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial x} = 0, & p = P_{atm} \\ x = l \rightarrow \frac{\partial u}{\partial x} = v = 0, & p = P_{atm} \end{aligned} \quad (11)$$

۳-۳- معادله انرژی

با درنظر گرفتن تمامی فرضهای بیان شده در بخش ۲، معادله انرژی به صورت زیر خواهد بود:

$$\rho c_p (u \cdot \nabla T) = k \nabla^2 T \quad (12)$$

که در آن c_p ظرفیت ویژه گرمایی و k رسانندگی گرمایی سیال می باشد.

با استفاده از تعریف دمای بی بعد (۱۳-الف) که در آن T_{mean} دمای متوسط کاسه ای مخلوط در هر مقطع کانال و به صورت (۱۳-ب) تعریف می شود، و با توجه به مقادیر طول بی بعد ($\bar{y}, \bar{x}, \bar{T}$) و سرعت بی بعد (\bar{u}, \bar{v}) که در روابط (۷) و (۱۰) ارائه شده اند، می توان شکل بی بعد معادله انرژی را به صورت رابطه (۱۳-ج) نوشت:

$$\bar{T} = \frac{T - T_{wall}}{T_{mean} - T_{wall}} \quad (13-\text{الف})$$

$$T_{mean}(x) = \left(\frac{1}{U_{mean}(x) A(x)} \right) \int T u dA \quad (13-\text{ب})$$

$$(\bar{u} \cdot \nabla \bar{T}) = \frac{1}{Re \times Pr} \nabla^2 \bar{T} \quad (13-\text{ج})$$

$$F = ma = \frac{mdu}{dt} \rightarrow \Delta u = \frac{(\tau_f \delta_t) F}{\rho} = \frac{\tau_f F}{\rho} \quad (22)$$

با توجه به آنچه در بخش ۲-۳ برای نیروی حجمی در جریان الکترواسمتیک گفته شد، می‌توان رابطه (۲۲) را به صورت زیر بازنویسی نمود:

$$u_{new}(x, y) = u_{old}(x, y) + \frac{\tau_f}{\rho} g_{rhs}(x, y) \varepsilon_r \varepsilon_0 \left(E_x - \frac{\partial \psi}{\partial x} \right) \quad (23)$$

مقادیر ماکروسکوپیک چگالی و سرعت و فشار نیز به صورت زیر محاسبه خواهند شد:

$$\rho = \sum_{i=0}^8 f_i, \quad \rho u = \sum_{i=0}^8 f_i e_i, \quad p = C_s^2 \rho = \frac{\rho}{3} \quad (24)$$

۴-۳-۴- مدل لتیس بولتزمن جهت حل معادله انرژی

چنانچه معادله بولتزمن را بر اساس انرژی داخلی نوشت و تابع توزیعی انرژی داخلی تعریف شود، معادله انرژی بولتزمن که معادل با معادله انرژی در محیط پیوسته است به دست خواهد آمد. شکل انفصالی معادله انرژی بولتزمن به صورت زیر است [۱۶]:

$$\theta_i(X + e_i \delta_t, t + \delta_t) - \theta_i(X, t) = -\frac{1}{\tau_\theta} [\theta_i(X, t) - \theta_i^{eq}(X, t)] \quad (25)$$

که در آن، θ_i تابع توزیعی انرژی داخلی و τ_θ مقدار بی بعد

تخفیف زمانی است که به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\tau_\theta = \frac{\alpha}{2c_p \delta_t T_{ave}} + 0.5$$

دماهای میانگین کل ناحیه مورد مطالعه می‌باشد. تابع تعادل ماقسول-بولتزمن برای رابطه (۲۵) به صورت (۲۶) است:

$$\begin{aligned} \theta_0^{eq} &= -\frac{2}{3} \rho \varepsilon \frac{u \cdot u}{C^2} \\ \theta_{1,2,3,4}^{eq} &= \frac{1}{9} \rho \varepsilon \left[\frac{3}{2} + \frac{3e_i \cdot u}{2C^2} + \frac{9(e_i \cdot u)^2}{2C^4} - \frac{3u \cdot u}{2C^2} \right] \\ \theta_{5,6,7,8}^{eq} &= \frac{1}{36} \rho \varepsilon \left[3 + \frac{3e_i \cdot u}{C^2} + \frac{9(e_i \cdot u)^2}{2C^4} - \frac{3u \cdot u}{2C^2} \right] \end{aligned} \quad (26)$$

که در آن $\varepsilon = c_p T$ انرژی داخلی در واحد جرم در مایعات می‌باشد. مقدار ماکروسکوپیک دما به صورت زیر محاسبه خواهد شد:

$$\rho \left(\frac{1}{2} c_p T \right) = \sum_{i=0}^8 \theta_i \quad (27)$$

معادله منفصل شده بولتزمن می‌باشد که به صورت زیر تعریف می‌شوند:

$$\omega_i = \frac{4}{9} (i = 0), \frac{1}{9} (i = 1,2,3,4), \frac{1}{36} (i = 5,6,7,8) \quad (16)$$

تابع توزیع تعادل ماقسول-بولتزمن به صورت زیر است:

$$g_i^{eq}(X, t) = \varpi_i \psi \quad (17)$$

در رابطه (۱۷)، ϖ_i ضرایب وزنی می‌باشد به صورت می‌باشد:

$$\varpi_i = \begin{cases} 0 & i = 0 \\ \frac{1}{6} & i = 1,2,3,4 \\ \frac{1}{12} & i = 5,6,7,8 \end{cases} \quad (18)$$

در نهایت مقدار ماکروسکوپیک پتانسیل الکتریکی به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$\psi = \sum_{i=0}^8 (g_i + 0.5 \delta_{t,g} \omega_i g_{rhs}) \quad (19)$$

۴-۲- مدل لتیس بولتزمن برای حل معادلات ناویر-استوکس

معادله انتقال بولتزمن که جهت حل معادلات ناویر-استوکس می‌باشد به صورت زیر است:

$$f_i(X + e_i \delta_t, t + \delta_t) - f_i(X, t) = -\frac{1}{\tau_f} [f_i(X, t) - f_i^{eq}(X, t)] \quad (20)$$

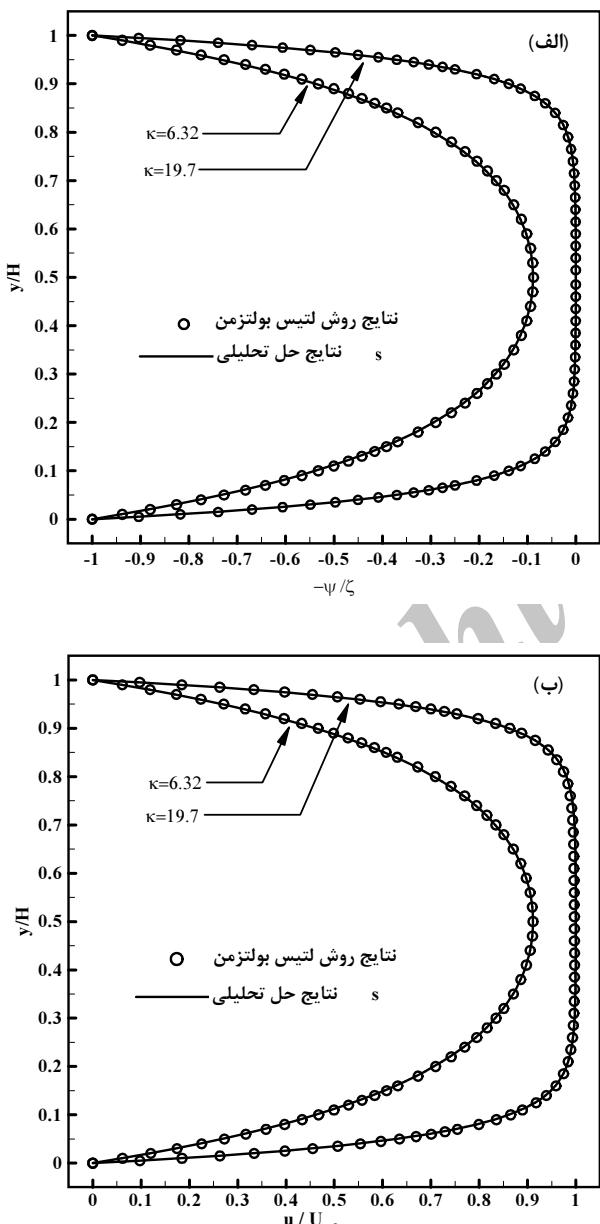
که در آن f_i تابع توزیع چگالی جهتی در مکان X و زمان t می‌باشد. τ_f مقدار بی بعد تخفیف زمانی است که به صورت $\tau_f = (\tau_f - 0.5) C_s^2 \delta_t$ با لزجت سینماتیک رابطه دارد که در آن C_s سرعت صوت در ماده بوده که با سرعت حرکت ذرات در شبکه $C = \frac{\delta_x}{\delta_t}$ به صورت $C = \frac{c}{\sqrt{3}}$ رابطه دارند. تابع تعادل ماقسول-بولتزمن برای رابطه (۲۰) به صورت زیر است:

$$f_i^{eq} = \omega_i \rho \left[1 + 3(e_i \cdot u) + \frac{9}{2} (e_i \cdot u)^2 - \frac{3}{2} u \cdot u \right] \quad (21)$$

که در آن u بردار سرعت ماکروسکوپیک، ρ چگالی سیال می‌باشد. جریان می‌تواند به واسطه مرزها و یا نیروی حجمی تحریک شده و به حرکت درآید. چنانچه نیروی حجمی عامل تحریک جریان باشد، می‌توان سرعت را پیش از محاسبه تابع تعادل (رابطه (۲۱)) به صورت زیر اصلاح نمود [۱۹]:

شکل ۲، تطابق خوب نتایج حاصل از حل تحلیلی [۱۸] و روش لتیس بولتزمن را برای پتانسیل الکتریکی داخلی و سرعت نشان می‌دهد.

جهت اعتبار سنجی حل معادله انرژی توسط روش لتیس بولتزمن، یک جریان توسعه یافته هیدرودینامیکی درون یک کانال با $\frac{L}{H} = 20$ که توسط نیروی حجمی به حرکت در می‌آید، درنظر گرفته شده است.



شکل ۲ توزیع پتانسیل الکتریکی داخلی - سرعت پتانسیل الکتریکی داخلی - α- توزیع

۴-۴- شرایط مرزی در روش لتیس بولتزمن

با توجه به شرایط مرزی که برای هر یک از معادلات مومنتوم، پواسون-بولتزمن و انرژی در بخش ۳ بیان شد، لازم است که این شرایط مرزی بر معادلات روش لتیس بولتزمن نیز اعمال شوند. از شرط مرزی زو-هی [۲۰] برای اعمال شرایط مرزی سرعت، شرط مرزی وانگ [۱۴] برای اعمال شرایط مرزی پتانسیل الکتریکی و از شرط مرزی لیو و همکاران [۲۱] برای اعمال شرایط مرزی معادله انرژی استفاده شده است.

۵- نتایج و بحث

با در نظر گرفتن آنچه در بخش ۴ بیان شد، در این بخش ابتدا حل عددی یک جریان هم دمای الکترواسمتیک و یک انتقال حرارت جابه‌جایی ساده درون یک کانال با حل‌های تحلیلی موجود اعتبار سنجی می‌شود. سپس یک جریان الکترواسمتیک درون ریز مجرای تخت که تحت اثرات میدان دمایی نیز می‌باشد مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

۵-۱- معیارها

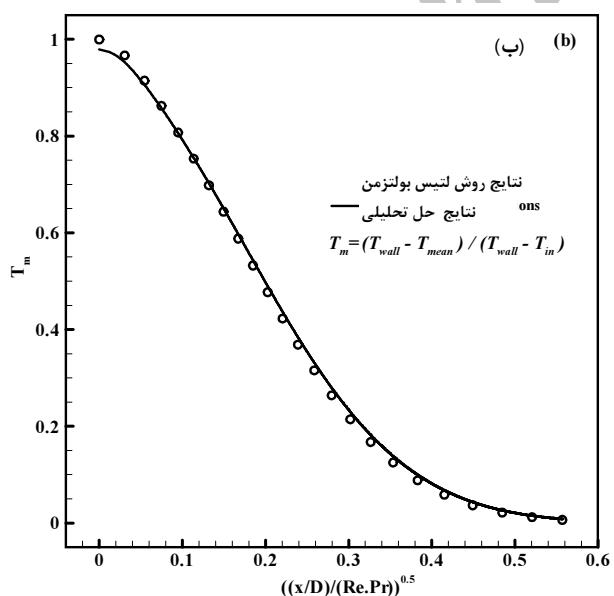
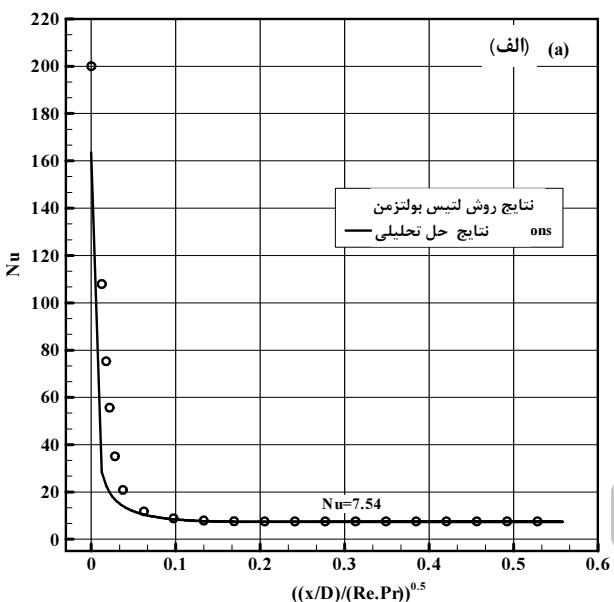
با توجه به آنچه در بخش ۲ بیان شد، چنانچه جریان الکترواسمتیک در این ریز مجرای توسعه یافته هیدرودینامیکی و یونی باشد، با توجه به برقراری رابطه $1 \leq \frac{Ze\zeta}{K_B T}$ می‌توان از تقریب دبای- هوکل استفاده نموده و در نتیجه حل تحلیلی برای سرعت و پتانسیل الکتریکی داخلی پیدا کرد [۱۸] که به صورت زیر می‌باشد:

$$\psi = \frac{\zeta \cosh\left(\kappa y - \frac{\kappa H}{2}\right)}{\cosh\left(\frac{\kappa H}{2}\right)} \quad (28-\text{الف})$$

$$\frac{u}{U_{ref}} = \left[1 - \frac{\cosh\left(\kappa y - \frac{\kappa H}{2}\right)}{\cosh\left(\frac{\kappa H}{2}\right)} \right] \quad (28-\text{ب})$$

جهت حل عددی مسئله، شبکه‌ای با 50×10^1 گره انتخاب شده است. دو مقدار $\kappa = 6.32$ و $\kappa = 19.7$ برای κ بیان نسبت ضخامت لایه دوگانه الکتریکی به عرض ریز مجرای نظر گرفته شده است. همچنین برای هر دو مقدار K ، عدد رینولدز برابر $Re = 5/3 \times 10^5$ اختیار شده است.

افزایش یابد (با ثابت ماندن E_x و κ) الگویی از جریان برگشتی با هسته متقاضی دوقلو نسبت به خط مرکزی کanal ایجاد خواهد شد. برای هر دو اختلاف دمایی خطوط جریان در ابتدای کanal (در ناحیه توسعه یابنده دمایی) به آرامی به سمت مرکز کanal متمایل می‌شوند. مشاهده می‌شود که با افزایش ΔT ، مقادیر پتانسیل الکتریکی با پیشروی به ناحیه مرکزی ریز مجرماً کوچک‌تر می‌شوند.



شکل ۳ $Pr = 0.7842$ و $Re = 82.08$ ، الف- عدد ناسلت محلی.
ب- دمای میانگین محلی

در این کanal دمای دیوارهای T_{wall} و همچنین دمای سیال ورودی T_{in} ثابت می‌باشند بهطوری که $T_{in} < T_{wall}$. با مقادیر $Pr = 0.7842$ و $Re = 82.08$ ، حل تحلیلی برای عدد ناسلت محلی و دمای میانگین محلی در طول کanal بر حسب عدد بی بعد گراتز:

$$\chi^+ = \frac{x}{H Re Pr}$$

و بر اساس سری‌های نامتناهی قابل بیان است [۲۲]. شکل ۳، نتایج حاصل از حل لتیس بولتزمن و حل تحلیلی [۲۲] را برای عدد ناسلت محلی و دمای میانگین محلی نشان می‌دهد. نتایج در ناحیه توسعه یافته تطابق خوبی با حل تحلیلی دارند.

در ناحیه توسعه یابنده حرارتی اختلافی مابین نتایج حاصل از حل تحلیلی و روش لتیس بولتزمن مشاهده می‌شود. حل‌های تحلیلی که بر اساس سری‌های نامتناهی ارائه شده‌اند در صورتی دقیق بالاتری را نتیجه خواهند داد که $Pe = Re \times Pr > 100$ باشد. لذا می‌توان علت این اختلاف را در داشتن مقدار $Pe = 64.36$ در این مسئله جستجو نمود.

۵- اثرات دمایی بر جریان الکترواسمتیک

پس از اعتبار سنجی بخش‌های کد عددی لتیس بولتزمن که به منظور حل معادلات مومنتوم، پواسون-بولتزمن و انرژی مورد استفاده قرار خواهند گرفت، حال در این بخش به بررسی اثرات دمایی بر جریان الکترواسمتیک پرداخته خواهد شد.

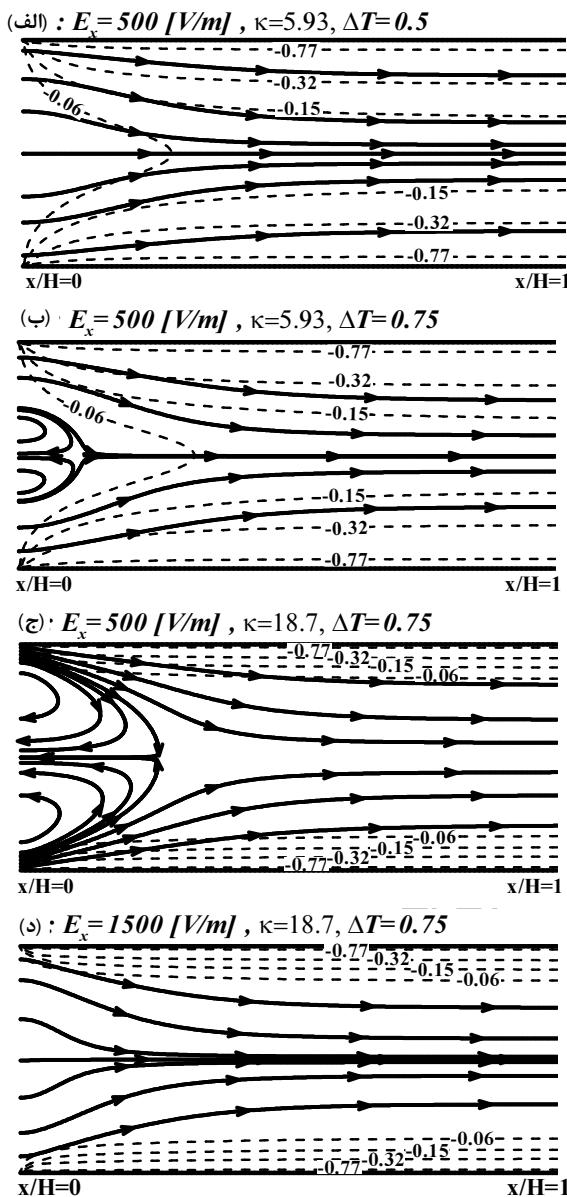
انتخاب شده و $T_{wall} = T_0 = 323.15$ K در این بخش اختلاف دمایی دیوارهای و جریان سیال ورودی به صورت $\Delta T = T_{wall} - T_{in}$ تعریف می‌شود. جهت نمایش بی‌بعد دما، $\Delta T = T_{wall} - T_{in}$ کل اختلاف دمایی بر دمای دیوارهای تقسیم شده و به منظور عدم استفاده از نماد جدیدی اختلاف دمای بی‌بعد به صورت:

$$\Delta T = \frac{T_{wall} - T_{in}}{T_{wall}}$$

نمایش داده خواهد شد. در این مقاله جهت بررسی اثرات دمایی بر جریان الکترواسمتیک دو اختلاف دمای $\Delta T = 0.5$ و $\Delta T = 0.75$ درنظر گرفته خواهد شد.

شکل ۴، خطوط ممتد جریان الکترواسمتیک را به همراه خطوط خط‌چین پتانسیل الکتریکی ثابت نشان می‌دهد. شکل‌های ۴-الف و ۴-ب نشان می‌دهند که چنانچه ΔT

مرکزی کانال متمایل شده و یا به عبارت دیگر توزیع پتانسیل الکتریکی در عرض ریز مجرای نواخته خواهد شد.



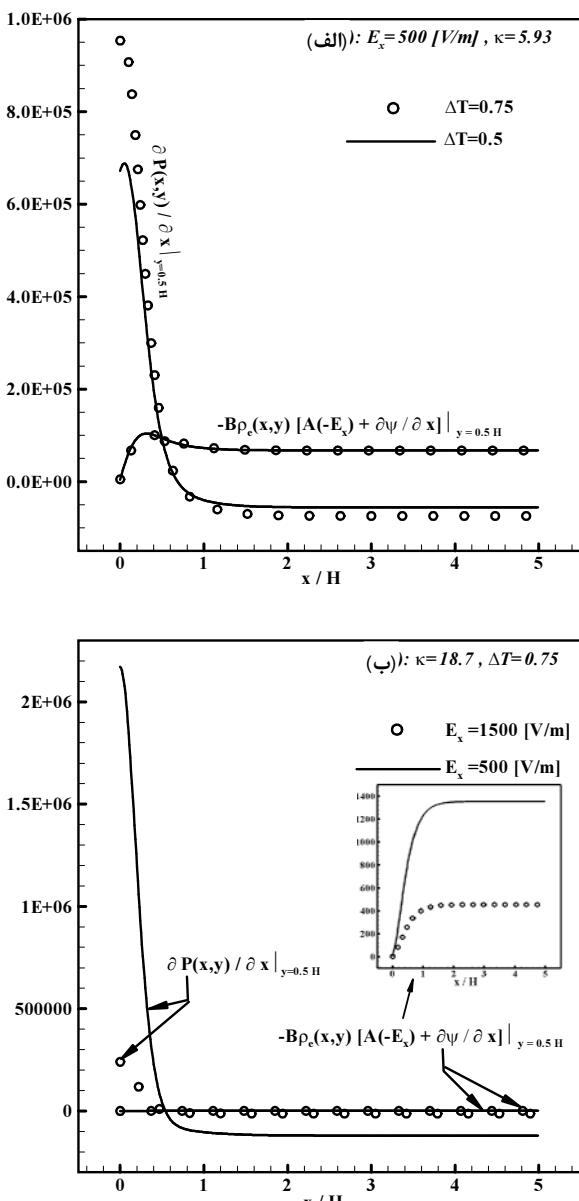
شکل ۴ طرح جریان الکترواسمتیک و پتانسیل الکتریکی داخلی، خطوط ممتد خطوط جریان الکترواسمتیک و خطچین خطوط پتانسیل الکتریکی داخلی ثابت

با توجه به ارتباط نیروی الکتریکی لورنس (نیروی حجمی) با چگالی خالص بار الکتریکی (ρ_e)، می‌توان نتیجه گرفت که در ابتدای ریز مجرای، نیروی الکتریکی لورنس در مجاورت دیوارهای بیشتر از نواحی مرکزی کانال بوده و به تدریج با پیشروعی در طول

در فاصله‌ای از ورودی ریز مجرای و در ناحیه توسعه یافته دمایی خطوط جریان و پتانسیل الکتریکی کاملاً افقی می‌شوند. شکل ۴-ج نشان می‌دهد که با افزایش ΔT و k (ثابت ماندن E_x) ناحیه جریان بازگشتی در ابتدای ریز مجرای فوق قرار می‌گیرد. همچنین خطوط پتانسیل الکتریکی به سمت دیواره متمایل شده‌اند و لذا نواحی مرکزی ریز مجرای دارای مقادیر کوچک‌تری از پتانسیل الکتریکی خواهند بود. شکل ۴-د نشان می‌دهد که با وجود افزایش مقادیر E_x افزایش ΔT و k ، افزایش مانع از ایجاد جریان بازگشتی در ابتدای کانال می‌شود. با این حال خطوط جریان در ابتدای ریز مجرای با شدت بیشتری نسبت به جریان الکترواسمتیک شکل ۴-الف، به سمت مرکز کانال متمایل می‌شوند.

مهم‌ترین ویژگی که جریان الکترواسمتیک در حضور میدان دمایی دارد انحراف خطوط جریان و پتانسیل الکتریکی به سمت ناحیه مرکزی ریز مجرای بر اثر تغییر توزیع یون‌ها می‌باشد تا آنجا که می‌تواند باعث بازگشت جریان در ناحیه ورودی ریز مجرای شود. همانطور که پیشتر نیز اشاره شد معادلات پواسون-بولتزمن و ناویر-استوکس اصلاح شده به تغییرات دمای سیال وابسته می‌باشند. با توجه به حل تحلیلی پتانسیل الکتریکی (رابطه ۲۸-الف)، چنانچه دما کاهش یابد (با ثابت فرض نمودن سایر پارامترها) مقدار پتانسیل الکتریکی نیز کاهش خواهد یافت. در ناحیه ورودی ریز مجرای دمای سیال هنوز تحت تاثیر دمای دیوارهای قرار نگرفته است لذا مقدار پتانسیل الکتریکی در ناحیه ورودی به ویژه در نواحی نزدیک به خط مرکزی ریز مجرای کوچک‌تر از حالتی است که سیال و دیوارهای هم‌دما باشند. با توجه به ثابت ماندن غلظت یون‌ها برای K یکسان (شکل‌های ۴-الف و ۴-ب) خطوط تراز پتانسیل الکتریکی (ψ) (خطوط خطچین) با افزایش اختلاف دما (ΔT) و در نتیجه کاهش دمای سیال ورودی و کاهش پتانسیل الکتریکی در نواحی مرکزی ریز مجرای، ناچارا در مجاورت دیواره تراکم بیشتری خواهد داشت.

با توجه به رابطه مستقیم توزیع چگالی خالص بار الکتریکی (ρ_e) با پتانسیل الکتریکی (ψ) و نفوذ خطوط تراز پتانسیل الکتریکی داخلی به سمت نواحی مرکزی ریز مجرای (شکل ۴)، می‌توان نتیجه گرفت که با گرم شدن تدریجی سیال ورودی در طول ریز مجرای، توزیع چگالی خالص بار الکتریکی به سمت خط



شکل ۵ گرادیان فشار و نیروی الکتریکی لورنس

۶- نتیجه‌گیری

دما می‌تواند به عنوان یک پارامتر مؤثر بر ویسکوزیته، رسانندگی گرمایی، ضریب گذردهی الکتریکی برای مواد مختلف، رسانندگی الکتریکی و همچنین توزیع زتا پتانسیل به منظور کنترل جریان الکترواسمتیک مورد بررسی قرار گیرد. مطالعات متعددی به منظور بررسی اثرات دما بر جریان الکترواسمتیک به واسطه تغییر در خواص الکتروفیزیکی یاد شده، انجام شده است. در این مقاله تنها به بررسی اثر دما بر توزیع یون‌ها به واسطه وابسته بودن توزیع چگالی خالص بار

ریز مجرای نیروی الکتریکی لورنس تمرکز خود را در نزدیکی دیواره‌ها از دست داده و به سمت نواحی مرکزی کانال متتمرکز می‌شود. تغییرات نیروی الکتریکی لورنس در عرض ریز مجرای موجب پیدایش یک گرادیان فشار القایی معکوس در ابتدای کانال می‌شود. میزان این گرادیان فشار القایی معکوس با افزایش ΔT - به دلیل کاهش نیروی الکتریکی لورنس در نواحی مرکزی و افزایش آن در نزدیکی دیواره‌های ریز مجرای افزایش خواهد یافت. لذا یک ناحیه از جریان بازگشتی دوقلو نسبت به خط مرکزی ریز مجرای در ابتدای آن ایجاد خواهد شد (شکل ۴- ب). افزایش κ (کاهش ضخامت لایه دوگانه الکتریکی) و همچنین افزایش ΔT باعث تجمع بیشتر خطوط تراز پتانسیل الکتریکی در نزدیکی دیواره‌های ریز مجرای شده و در نتیجه میزان نیروی الکتریکی لورنس در نواحی مرکزی ریز مجرای کاهش خواهد یافت.

این کاهش بیشتر نیروی الکتریکی لورنس در ورودی و نواحی نزدیک خط مرکزی ریز مجرای، باعث غلبه گرادیان فشار القایی معکوس شده و لذا بخش وسیع تری از جریان در ورودی ریز مجرای دارای الگوی بازگشتی خواهد شد (شکل ۴- ج).

با افزایش قدرت میدان الکتریکی خارجی (E_x)، نیروی الکتریکی لورنس در تمامی ریز مجرای افزایش خواهد یافت. این افزایش در تقابل با گرادیان فشار القایی معکوس باعث کوچکتر شدن ناحیه جریان بازگشتی می‌شود. چنانچه مقدار E_x به اندازه کافی بزرگ شود ناحیه با جریان بازگشتی حذف خواهد شد (شکل ۴- د). می‌توان تمامی استدلال‌های فوق را با رسم نمودارهایی که گرادیان فشار (∇P) و نیروی الکتریکی لورنس شکل ۵، مقادیر ∇P و $-B\rho_e \left[A(-E_x) + \frac{\partial \psi}{\partial x} \right]$ را شامل شوند، نشان داد.

شکل ۵، مقادیر ∇P و $-B\rho_e \left[A(-E_x) + \frac{\partial \psi}{\partial x} \right]$ را برای چهار حالت مطرح در شکل ۴ و $y = 0.5H$ نشان می‌دهد. برای هر چهار حالت طرح شده، در ابتدای ریز مجرای ∇P بزرگتر از $-B\rho_e \left[A(-E_x) + \frac{\partial \psi}{\partial x} \right]$ است. با پیش روی در طول ریز مجرای مقدار $0 < \nabla P$ شده و کوچکتر از نیروی الکتریکی لورنس خواهد شد. در ابتدای ریز مجرای $\nabla P_{\Delta T=0.75} > \nabla P_{E_x=500} > \nabla P_{E_x=1500} > \nabla P_{\Delta T=0.5}$ است و با پیش روی در طول ریز مجرای این روابط بر عکس خواهند شد. شکل ۵- الف نشان می‌دهد که با افزایش مقدار ΔT تغییر محسوسی در نیروی الکتریکی لورنس ایجاد نمی‌شود. شکل ۵- ب نشان می‌دهد که افزایش E_x باعث افزایش مقدار نیروی الکتریکی لورنس خواهد شد.

- [10] Zhao T. S. and Liao Q., "Thermal Effect on Electro-Osmotic Pumping of Liquids in Micro-Channels", *J. of Micromechanics and Microengineering*, Vol. 12, 2002, pp. 962.
- [11] Tang G. H., Li Z., Wang J. K., He Y. L. and Tao W. Q., "Electroosmotic Flow and Mixing in Microchannels with the Lattice Boltzmann Method", *J. Appl. Phys.* Vol. 100, 2006, pp. 094908.
- [12] Chai Z. and Shi B., "Simulation of Electro-Osmotic Flow in Microchannel with Lattice Boltzmann Method", *Pys. Letters A.* Vol. 364, 2007, pp. 183.
- [13] Shi Y., Zhao T.S. and Guo Z., "Simplified Model and Lattice Boltzmann Algorithm for Microscale Electro-Osmotic and Heat Transfer", *Int. J. Heat Mass Transfer*, Vol. 51, 2008, pp. 586.
- [14] Wang J., Wang M. and Li Z., "Lattice Poisson-Boltzmann Simulations of Electro-Osmotic Flows in Microchannels", *J. of Colloid and Interface Science*, Vol. 296, 2006, pp. 729.
- [15] Chen S. and Doolen G. D., "Lattice Boltzmann Method for Fluid Flows", *Annu. Rev. Fluid Mech.*, Vol. 30, 1998, pp. 329.
- [16] He X., Chen S. and Doolen G.D., "A Novel Thermal Model for the Lattice Boltzmann Method in Incompressible Limit", *J. of Computational Physics*, Vol. 146, 1998, pp. 282.
- [17] Masliyah J.H., *Electrokinetic and Colloid Transport Phenomena*, New York, Wiley, 2006.
- [18] Mirbozorgi S.A., Niazzmand H. and Renksizbulut M., "Streaming Electric Potential in Pressure Driven Flows Through Reservoir- Connected Microchannels", *J. of Fluid Engineering*, Vol. 129, 2007, pp. 1346.
- [19] Sukop M.C. and Throne D.T., *Lattice Boltzmann Modeling and Introduction for Geoscientist and Engineers*, Springer, 2007.
- [20] Zou Q. and He X., "On Pressure and Velocity Flow Boundary Condition and Bounceback for the Lattice Boltzmann BGK Model", *J. Phys. Fluids*, Vol. 9, 1997, pp. 1591.
- [21] Liu C.H., Lin K.H., Mai H.C. and Lin C.A., "Thermal Boundary Conditions for Thermal Lattice Boltzmann Simulations", *Computers and Mathematics With Applications*, Vol. 59, 2010, pp. 2178.
- [22] Kays W.M. and Crawford M.E., *Convective Heat and Mass Transfer*, New York, Mc Graw Hill, 1993.

الکتریکی به دما، پرداخته شده است. با استفاده از دمای میانگین کاسه‌ای مخلوط در معادله پواسون-بولتزمن، می‌توان توزیع پتانسیل الکتریکی را به دست آورد. نتایج نشان دادند که میدان دمایی بر توزیع یون‌ها اثر داشته به نحوی که باعث ایجاد گرادیان فشار معکوسی بیشتر از نیروی حجمی الکتریکی شده و در نتیجه جریان برگشتی در ابتدای ریز مجراء ایجاد می‌کند. همچنین مشاهده شد که با افزایش مقدار ΔT ، E_x و κ دی‌عبوری از ریز مجراء نیز افزایش یافت.

-۷- مراجع

- [1] Kandlikar S.G., Garimella S., Li D., Colin S. and King M.R., *Heat Transfer and Fluid Flow in Minichannels and Microchannels*, Amsterdam, Elsevier, 2006.
- [2] Stone H.A., Stroock A.D., Ajdari A. and Annu A., "Engineering Flow in Small Devices Microfluidics Toward a Lab-On-a-Chip", *Rev. Fluid Mech.*, Vol. 36, 2004, pp. 381.
- [3] Giddings J.C., "New Separation Concept Based on a Coupling of Concentration and Flow Non-Uniformities" *Sep. Sci.*, Vol. 1, 1966, pp. 123.
- [4] Bau H.H., Zhong H.H. J. and Yi M., "A minute Magneto Hydro Dynamic (MHD) mixer", *Sensors Actuators B*, Vol. 79, 2001, pp. 207.
- [5] Mirbozorgi S.A., Niazzmand H. and Renksizbulut M., "Electro-Osmotic Flow in Reservoir- Connected Flat Microchannels With Non-Uniform Zeta Potential", *J. of fluid engineering*, Vol. 128, 2006, pp. 1133.
- [6] Herr A.E., Molho J.I., Santiago J.G., Mungal M.G., Kenny T.W. and Garguilo M.G., "Electro-Osmotic Capillary Flow with Non-Uniform Zeta Potential", *Anal. Chem.*, Vol. 72, 2000, pp. 1053.
- [7] M Schasfoort R.B., Schlautmann S. and Hendrikse J., Van den Berg A., "Filed-effect Flow Control for Microfabricated Fluidic Networks", *Science*, Vol. 286, 1999, pp. 942.
- [8] Mala G.M., Li D. and Dale J.D., "Heat Transfer and Fluid Flow in Microchannels", *Int. J. Heat Mass Transfer*, Vol. 47, 2004, pp. 987.
- [9] Kwak H.S., Kim H., Hyun J.M. and Song T-H., "Thermal Control of Electroosmotic Flow in a Microchannel Through Temperature-Dependent Properties", *J. of Colloid and Interface Science*, Vol. 335, 2009, pp. 123.